

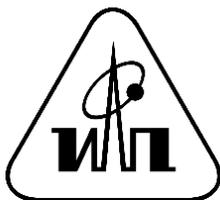
ПРОГРАММА
Школы молодых ученых
по оптическим и фотоэлектрическим свойствам
полупроводниковых квантовых систем
«Оптика и фотоэлектрика квантовых систем»

8–9 ноября 2023 г.

ИФП СО РАН, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева 13, конференц-зал (3 этаж)

Среда, 8 ноября

8:30 – 9:00	Регистрация участников Школы		
9:00 – 9:15	Открытие		
9:15 – 10:00	<u>Квон Зе Дон</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Двумерные полуметаллы
10:00 – 10:45	<u>Тарасенко Сергей Анатольевич</u>	ФТИ РАН, г. Санкт- Петербург	Фототоки, индуцированные структурированным излучением
10:45 – 11:00	<i>Перерыв, кофе-брейк</i>		
11:00 – 11:45	<u>Ткаченко Виталий Анатольевич</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Туннелирование в поле электромагнитного излучения
11:45 – 12:30	<u>Девятов Эдуард Валентинович</u>	ИФТТ РАН, г. Черноголовка	Магнитный вейлевский полуметалл: поверхностные состояния в транспортных экспериментах
12:30 – 13:15	<u>Шайблер Генрих Эрнстович</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Полупроводниковые фотокатоды: принцип работы и применения
13:15 – 14:00	<i>Обед</i>		
14:00 – 17:00	Представление стендов участниками Школы		
	<i>Перерыв, кофе-брейк</i>		
	Стендовая сессия		



Четверг, 9 ноября

9:00 – 9:45	<u>Наумова</u> <u>Ольга</u> <u>Викторовна</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Поглотители на основе черных металлов: морфология, электрические и оптические свойства
9:45 – 10:30	<u>Шкляев</u> <u>Александр</u> <u>Андреевич</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Рассеяние света покрытиями из диэлектрических частиц субволнового размера
10:30 – 11:15	<u>Михайлов</u> <u>Николай</u> <u>Николаевич</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Молекулярно-лучевая эпитаксия HgCdTe для детекторов и источников ИК излучения
11:15 – 11:30	<i>Перерыв, кофе-брейк</i>		
11:30 – 12:15	<u>Исламов</u> <u>Дамир</u> <u>Ревинирович</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Универсальная память: миф или будущее?
12:15 – 13:00	<u>Рябцев</u> <u>Игорь</u> <u>Ильич</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Квантовая информатика с одиночными атомами и фотонами
13:00 – 13:15	Вручение дипломов. Закрытие Школы		

Стендовая сессия, 8 ноября, 14:00 – 17:00, холл перед конференц-залом

№ стенда	ФИО участника	Организация	Название доклада
1	Баженов Александр Олегович	Новосибирский государственный университет	Нелинейный эффект Холла и положительное магнетосопротивление в пленках трехмерного топологического изолятора $(\text{Bi,Sb})_2(\text{Te,Se})_3$
2	Казанцев Дмитрий Михайлович	Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН	Возможные механизмы формирования тонкой структуры в распределении по энергии электронов, эмитированных из p-GaAs(Cs,O)
3	Козорез Анастасия Владимировна	Томский государственный университет	Особенности численного моделирования NV-центра во внешнем магнитном поле
4	Кузьмин Никита Сергеевич	Новосибирский государственный университет	Особенности поведения СВЧ-фотопроводимости квантовых точечных контактов на основе различных AlGaAs/GaAs гетероструктур
5	Кукенов Олжас Игоревич	Томский государственный университет	Исследование сверхструктурных изменений методом ДБОЭ при синтезе Ge на Si(100)
6	Махмудиан Мехрдад Махмудович	Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН	Теория комбинационного рассеяния света на двумерном вигнеровском кластере
7	Микаева Анастасия Сергеевна	Новосибирский государственный университет	Электронная структура PbSnTe:In с составами вблизи точки инверсии зон
8	Рудева Яна Сергеевна	Новосибирский государственный технический университет	Упорядоченные GeSi квантовые точки, встроенные в дисковые резонаторы
9	Снегирев Андрей Вячеславович	Новосибирский государственный университет	Гальваномеханические эффекты в гексагональных дираковских 2D монослойных материалах
10	Соколов Арсений Сергеевич	Томский государственный университет	Особенности изменений картин дифракции при гомоэпитаксиальном росте Si на Si(100)
11	Соловова Надежда Юрьевна	Новосибирский государственный университет	Электронная и кристаллическая структура тонких плёнок Bi/InAs(111)A(2x2)
12	Сорокин Дмитрий Владимирович	Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН	Фотопроводимость графена на кремниевой подложке
13	Хорошилов Владимир Сергеевич	Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН	Вероятность выхода фотоэлектронов в вакуум из GaAs(Cs) и GaAs(Cs,O)